

P-CHANNEL J-FET

Qualified per MIL-PRF-19500/476

Devices

Qualified Level

2N5114 2N5115 2N5116

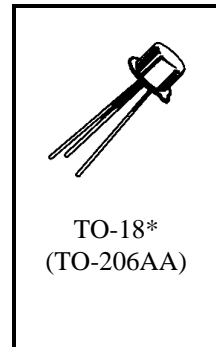
JAN
JANTX
JANTXV

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_C = +25⁰C unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	All Devices	Unit
Gate-Source Voltage ⁽¹⁾	V _{GS}	30	Vdc
Drain-Source Voltage ⁽¹⁾	V _{DS}	30	Vdc
Drain-Gate Voltage	V _{DG}	30	Vdc
Gate Current	I _G	50	mAdc
Power Dissipation T _A = +25 ⁰ C ⁽²⁾	P _T	0.500	W
Storage Temperature Range	T _{stg}	-65 to +200	⁰ C

(1) Symmetrical geometry allows operation of those units with source/drain leads interchanged.

(2) Derate linearly 3.0 mW/⁰C for T_A > 25⁰C.



*See appendix A for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_C = +25⁰C unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Units
Gate-Source Breakdown Voltage V _{DS} = 0, I _G = 1.0 μAdc	V _{(BR)GSS}	30		Vdc
Drain-Source "On" State Voltage V _{GS} = 0 Vdc, I _D = -15 mAdc	V _{DS(on)}		1.3	Vdc
V _{GS} = 0 Vdc, I _D = -7.0 mAdc			0.8	
V _{GS} = 0 Vdc, I _D = -3.0 mAdc			0.6	
Gate Reverse Current V _{DS} = 0, V _{GS} = 20 Vdc	I _{GSS}		500	pAdc
Drain Current Cutoff V _{GS} = 12 Vdc, V _{DS} = -15 Vdc	I _{D(off)}		-500	pAdc
V _{GS} = 7.0 Vdc, V _{DS} = -15 Vdc			-500	
V _{GS} = 5.0 Vdc, V _{DS} = -15 Vdc			-500	

2N5114, 2N5115, 2N5116 JAN SERIES

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_C = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted) (con't)

Parameters / Test Conditions		Symbol	Min.	Max.	Units	
Zero Gate Voltage Drain Current $V_{GS} = 0, V_{DS} = -18 \text{ Vdc}$ 2N5114 $V_{GS} = 0, V_{DS} = -15 \text{ Vdc}$ 2N5115 $V_{GS} = 0, V_{DS} = -15 \text{ Vdc}$ 2N5116		I_{DSS}	-30 -15 -5.0	-90 -60 -25	mAdc	
Small-Signal Drain - Source "On" State Resistance $V_{GS} = 0, I_D = -1.0 \text{ mAdc}$ 2N5114 2N5115 2N5116 $V_{GS} = 0, I_D = 0; f = 1 \text{ kHz}$ 2N5114 2N5115 2N5116		$r_{ds(on)}$		75 100 175 75 100 175	Ω	
Gate-Source Cutoff $V_{DS} = -15, I_D = 1.0 \text{ mAdc}$ 2N5114 $V_{DS} = -15, I_D = 1.0 \text{ mAdc}$ 2N5115 $V_{DS} = -15, I_D = 1.0 \text{ mAdc}$ 2N5116		$V_{GS(off)}$	5.0 3.0 1.0	10 6.0 4.0	Vdc	
Small-Signal, Common-Source Short-Circuit Reverse Transfer Capacitance $V_{GS} = 12 \text{ Vdc}, V_{DS} = 0$ 2N5114 $V_{GS} = 7.0 \text{ Vdc}, V_{DS} = 0$ 2N5115 $V_{GS} = 5.0 \text{ Vdc}, V_{DS} = 0$ 2N5116		C_{rss}		7.0	pF	
Small-Signal, Common-Source Short-Circuit Input Capacitance $V_{GS} = 0, V_{DS} = -15 \text{ Vdc}, f = 1.0 \text{ MHz}$ 2N5114, 2N5115 2N5116		C_{iss}		25 27	pF	
Turn-On Delay Time	2N5114 2N5115 2N5116	See Figure 2 of MIL-PRF- 19500/476	t_{don}	6 10 25	ηs	
Rise Time	2N5114 2N5115 2N5116			t_r		10 20 35
Turn-Off Delay Time	2N5114 2N5115 2N5116			t_{doff}		6 8 20



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331